(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許出願公開番号 特開2002-313554 (P2002-313554A)

(43)公開日 平成14年10月25日(2002.10.25)

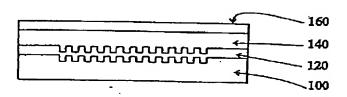
(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ	-		テーマコード(参考)	
H05B	33/02		H 0 5 B 33/02 33/10 33/12 33/14 33/22			3 K 0 0 7 Z B Z	
	33/10						
	33/12						
	33/14						
	33/22						
			家在請求	未請求	請求項の数2	O OL (全 10 頁)	
(21)出願番号		特顏2001-117255(P2001-117255)	(71)出願人	000002369			
			セイコーエプソン株式会社				
(22)出願日		平成13年4月16日(2001.4.16)	東京都新宿区西線			新宿2丁目4番1号	
			(74)代理人	100095728			
				弁理士	上柳 雅誉	(外1名)	
		•					

(54) 【発明の名称】 発光素子及び発光素子の製造方法

(57)【要約】

【課題】素子の効率を改良した発光素子を提供すること。

【解決手段】基材100、前記基材100上に形成された透明電極120、該透明電極120上に設けられ少なくとも1つの波型表面を有する発光材料層140、および該発光材料上に形成された更なる電極160を具備する発光素子。



最終頁に続く

【特許請求の範囲】

【請求項1】基材、前記基材上に形成された透明電極、 該透明電極上に設けられ少なくとも1つの波型表面を有 する発光材料層、および該発光材料層上に形成された更 なる電極を具備する発光素子。

【請求項2】 前記発光材料が有機材料である請求項1 記載の発光素子。

【請求項3】 前記基材が波型表面を有する請求項1ま たは2記載の発光素子。

前記透明電極上に導電性ポリマー層が形 10 【請求項4】 成され、該導電性ポリマー層が透明電極に面する表面の 反対側に波型表面を有し、前記発光材料が該導電性ポリ マー層の波型表面と接している請求項1または2記載の 発光素子。

前記発光材料が1000cm ̄ュ以下の 吸収係数を有する請求項1乃至4のいずれかに記載の発 光素子。

【請求項6】 前記発光材料が共役ポリマーからなる請 求項1乃至5のいずれかに記載の発光素子。

前記発光材料がポリフルオレン誘導体か 20 【請求項7】 らなる請求項1乃至5のいずれかに記載の発光素子。

前記波型表面が式:Λ=v λ。/n s i 【請求項8】 $n\theta$ mによるピッチ Λ を有する(角 θ mは、発光材料の 層の上側および下側表面からの、発光材料中の導波路モ ード (waveguide mode) mで伝播する光についての発光 材料層の上側および下側表面からの反射角であり、ん。 は出力波長であり、nおよびvは整数である)請求項1 乃至7記載の発光素子。

【請求項9】 前記波型表面のピッチが300~450 nmの範囲である請求項1乃至8のいずれかに記載の発 30 光素子。

【請求項10】前記波型表面が一次元の周期構造を有す る請求項1乃至9のいずれかに記載の発光素子。

【請求項11】前記波型表面が二次元の周期構造を有す る請求項1乃至9のいずれかに記載の発光素子。

【請求項12】前記波型表面が三次元の周期構造を有す る請求項1乃至9のいずれかに記載の発光素子。

【請求項13】前記波型表面がチャープ格子構造(stru cture of chirping grating) を有する請求項1乃至9 のいずれかに記載の発光素子。

【請求項14】前記発光材料層が複数の領域を有し、各 領域はそれぞれ異なるピッチの波型表面を有する請求項 1乃至13記載のいずれかに発光素子。

【請求項15】基材を提供する工程と、該基材上に透明 電極を形成する工程と、該透明電極上に発光材料層を設 ける工程と、発光表面が少なくとも1つの波型表面を有 するように調整する工程と、該発光材料層上方に他の電 極を形成する工程を具備する発光索子の製造方法。

【請求項16】前記発光表面が少なくとも1つの波型表

面設ける工程を含む請求項15記載の発光素子の製造方 法。

【請求項17】前記基材に光硬化性樹脂を設ける工程 と、型を用いて樹脂を成形することによって基材上に波 型表面を形成する工程と、該樹脂を放射線に曝して樹脂 を硬化する工程を具備する請求項16記載の発行素子の 製造方法。

【請求項18】導電性ポリマー層を透明電極上に形成す る工程を更に具備し、前記発光表面が少なくとも1つの 波型表面を有するように調整する工程が、該導電性ポリ マー層上に波型表面を設ける工程を含む請求項15記載 の発光素子の製造方法。

【請求項19】ポリマーの型を用いて層を成形すること によって導電性ポリマー層上に波型表面を形成する工程 と、熱を印加することによって層を硬化する工程を具備 する請求項18記載の発光素子の製造方法。

【請求項20】前記導電性ポリマー層上に波型表面を設 ける工程が: 導電性ポリマー材料を透明電極上にスピン コートする工程と、導電性ポリマー材料を型の波型表面 上にスピンコートする工程と、該スピンコートされた型 を透明電極上に設けられた導電性ポリマー層上に配置し 2つの導電性ポリマー層を一体に挟むようにする工程 と、次に型を取り除くことを具備する請求項18記載の 発光素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は特に、基材、透明電 極、発光材料層および第2の電極を含有する構造を有す る発光素子に関する。

[0002]

【従来の技術】上述したような構造の発光素子では、正 孔を発光材料へと一方電極(通常透明電極)から注入 し、電子を他方電極から注入する。発光または活性材料 における電子正孔再結合は光を生じる。発生した光は素 子から透明電極を通って放出される。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、素子 の効率を改良した前述のタイプの発光素子を提供するこ とである。

40 [0004]

> 【課題を解決するための手段】本発明の第1の観点によ れば、基材、前記基材上に形成された透明電極、該透明 電極上に設けられ少なくとも1つの波型表面を有する発 光材料層、および該発光材料上に形成された更なる電極 具備する発光素子が提供される。好ましい構成として は、波型表面を有する基材、前記波型表面上に形成され た透明電極、透明電極上に提供された発光材料層、およ び発光材料上に形成された更なる電極を具備する。

【0005】別の好ましい構成では、基材、基材上に形 面を有するように調整する工程が、前記基材上に波型表 50 成された透明電極、透明電極上に形成され、透明電極に

面する表面の反対側に波型表面を有する導電性ポリマー 層、前記波型表面と接している発光材料、および発光材 料上に形成された更なる電極を具備する発光素子が提供 される。

【0006】本発明の第2の観点によれば、基材を提供する工程と、該基材上に透明電極を形成する工程と、該透明電極上に発光材料層を設ける工程と、発光表面が少なくとも1つの波型表面を有するように調整する工程と、該発光材料層上方に他の電極を形成する工程を具備する発光素子の製造方法が提供される。

【0007】好ましい方法では、発光表面が少なくとも 1つの波型表面を有するように調整する工程が、基材上 に波型表面を提供することを包含する。

【0008】別の好ましい方法は、導電性ポリマー層を 透明電極上に形成する工程を包含し、この方法におい て、発光表面が少なくとも1つの波型表面を有するよう に調整する工程が、導電性ポリマー層上に波型表面を設 けることを包含する。

【0009】本発明において非常に好ましくは、発光材料は有機材料である。

【0010】従来の素子では、発光材料層は導液路として機能し、発生した光の実質部分を活性材料内の導液路モード(waveguide mode)にトラップすることができることが見出されている。発光材料の屈折率が高いほど、発光材料中の導液路モードにトラップされる発生した光の割合が大きくなる。従って、この考えは、発光層として有機材料の使用、特に共役ポリマーを活性材料として使用する場合に重要である。これは、有機材料、特に共役ポリマーが、有機材料から発光される光の波長付近で高い屈折率を有するからである。

【0011】ある種の電子ポンピングレーザ素子 (elec tronically pumped laser device) 内に波型表面を使用する提案がなされていたことは理解されている。しかし、このような素子は基本的に、本発明が適用する発光素子に比べて、異なる構造および動作モードを有する。更に、従来の提案は主に理論的性質のものであり、実際に組み立てることは不可能ではないにしても、非常に困難な素子を仮定していた。

[0012]

【発明の実施の形態】本発明の実施態様を、ここで添付 40 の図面を参照しながら更なる実施例で記載する。

【0013】本発明は、活性層が波型表面を有する発光 素子を提供する。この波型の活性層の効果は、本発明に よる発光素子の効率を向上させることである。波型のピ ッチは、その幅が小さいほど、以下に記載するように、 素子の機能に影響する。しかし、本発明の実施態様につ いて、特に留意すべき4つの領域がある。これらは:製 造方法、活性層中の光損失、波型のピッチおよび波型の 周期構造である。特に留意すべきこれらの4つの領域の それぞれを以下に議論し、続いて具体的な実施例を記載 50 する。

【0014】(製造方法)本発明特有の有効性は、多くの異なった製造方法が本発明による発光素子を製造する際の使用に好適であることである。

【0015】本発明による発光素子で使用するための基

材を形成する方法を、図1に例示する。この構成では、 基材10は2つの構成要素、即ち透明ベース12と光重 合樹脂14を含有する。図1aに示すように、光重合性 樹脂14をベース材料12の上側表面に塗布する。図1 bに示すように、光重合性樹脂14はスタンピング型 (stamping mold) 16の波型部分の領域と少なくとも 同じ大きさの領域を覆っている。スタンピング型を光重 合性樹脂14に押し付けるのだが、ここでこれは光重合 性樹脂14を均一な厚さの層へと平らに伸ばす効果を有 する(過剰の樹脂はエッジから外部に流出する)。この 操作は好ましくは、真空中で行われ、樹脂層中に泡が発 生するのを防止するようにする。図1 cに示すように、 UV放射線を透明基材12を介して照射することによっ て、樹脂14を硬化する。樹脂を硬化した後、スタンピ 20 ング型を除去して、波型の上側表面18を有する処理さ れた基材10を残す。この波型表面を用いて波型の活性 層を形成する。この方法は特に大型の製品に適してい

【0016】導電性ポリマー層を溶液からのスピンコートによって形成する。導電性ポリマー層の表面も波型を有する。これは光重合層上の波型と正確に同じではなく、僅かに浅めで丸めである。また、導電性ポリマー層の代わりに、正孔輸送層も適用可能である。スピンコートはポリマータイプの正孔輸送層に好適であり、その一方で低分子タイプの正孔輸送層には蒸着法が好適である。発光層については、(ポリマータイプか、低分子タイプかという)タイプに依存して、スピン塗布または蒸着を用いる。続いて陰極を金属の蒸着によって形成する。

【0017】図1の方法により形成された基材を使用す

る代わりに、透明電極がその上に形成され、電極上に形成された導電性ポリマーフィルムを備えた透明基材の構成を使用し、ここで導電性ポリマーは波型表面を有する。このような別の部品を形成する方法を図2に示す。【0018】図2では、部品20を、インジウム錫酸化物(ITO)電極24をその上に有する透明基材を設けることによって形成する。図2aに示すように、透明ポリマーマトリックスに埋め込まれた共役ポリマーの溶液26を、ITO電極24の上側表面に塗布する。図2bに示すように、溶液26はスタンピング型28の波型部分の領域と少なくとも同じ大きさの領域を覆っている。スタンピング型を溶液26しっかりとに押し付けるのだが、この操作は溶液を均一な厚さの層へと平らに伸ばす効果を有する。こうして得られたものを次に加熱することによって乾燥させ溶液26中の固形含有物を固化させ

る。固形含有物を固化じた後、スタンピング型を除去して、波型の上側表面30を有する基材20を完成させる。

【0019】図1の方法では、金属(例えば、ニッケル)のスタンピング型を使用することができるが、金属スタンピング型の使用は、溶剤の蒸発が乾燥工程中に要求される図2の方法には適さないと考えられ得る。 従って、図2の方法では、溶剤が浸透することができるポリマー製のスタンピング型を使用してもよい。更に、図2の方法は真空乾燥の使用を含んでもよい。

【0020】部品20を形成する別の方法を図3に示 す。図3の方法は2つの構成要素を形成し、これを積層 して1つの部品とすることを包含する。まず、導電性ポ リマー材料32をスタンピング型34上にスピンコート することによって塗布する。図3aに示すように、スピ ンコートされた材料32はスタンピング型34の波型に 従った波型の上側表面を有してもよい。透明基材38、 ITO電極40および導電性ポリマー42から成る構成 要素を、図3bに示すように別途形成する。スピンコー トされたスタンピング型34を逆さにし他方の構成要素 20 の上に配置して、ポリマー32と42が互いに接するよ うにする。図3 c に示すように、圧力(熱でもよい)を かけて2つの構成要素を一体に積層する。ポリマー32 と42は結合して単一層44を形成する。ポリマーは特 にガラス転移温度以上の温度で可塑特性を有する。ポリ マー32と42はその表面形態において違いはなく、可 塑特性によって、ポリマーは結びついて単一層44を形 成する。その後、スタンピング鋳型34を図3dに示す ように、除去して、透明ベース38、その上に形成され たITO電極40および、ITO上に形成され、波型の 30 上側表面46を有する導電性ポリマー層44を有する単 一の構成要素を残す。

【0021】所望の構成要素を形成するまた更なる方法 を図4に示す。この方法は図2のポリマー溶液法と図3 の積層法の組み合わせを用いる。具体的には、図4aに 示すように、導電性ポリマー材料48をスタンピング型 50にスピンコートすることによって塗布する。別に、 その上に I T O 電極 5 4 を有する透明基材 5 2 を、図 4 bに示すように、導電性ポリマー溶液56をITO表面 に塗布することにより調製する。次に、図4cに示すよ うに、スピンコートされた型50を逆さにしポリマー溶 液56に押し付ける。次に熱を印加して、溶剤を蒸発さ せ、ポリマー48と56から単一層58を形成する。使 用するポリマーが積層法にとって十分な可塑性がない場 合でも、この方法は波型表面を有する単一層を形成する ことができる。先と同様に、型の除去は、透明ベース、 その上に形成されたITO電極および、ITO上に形成 され、波型の上側表面を示す導電性ポリマーを有する単 一の構成要素を残す。

【0022】図5は図1に示す方法により製造された基 50

材を用いた発光素子を示す。図5では、透明基材を符号 100で示し、透明ITO電極を符号120で示し、発 光ポリマーを符号140で示し、金属電極を符号160 で示す。図6は図2に示す方法により製造された基材を 用いた発光素子を示す。図3に示す方法により製造された を発光素子だけでなく、図4の方法により製造されたも のも図6に示すものと同じである。図6および図5で使 用する共通の符号は、同じ基本的な構成要素を示すが、 図6において、基材もITOも波型ではない。図6にお いて、波型表面を活性層140に提供するのは、符号1 30で示す導電性ポリマー層である。

【0023】使用の際、電圧を印加して表示素子を駆動 する。典型的に、電圧は2V~10Vの範囲である。正 の電圧を陽極に印加し、陰極を接地することができる。 【0024】波型表面の機能的効果について、図1の方 法により形成された実施態様、及び図2~4による方法 のいずれかにより形成された実施態様に関して述べる。 特に、波型表面の基本的機能は導波伝播モード (wavegu ide propagation mode) を放射モード (radiative mod e) と接合することによって;導波路モードにおいて従 来どおりトラップされていた発生光の多くを放射モード において素子から(即ち、活性層に垂直に透明基材を通 って)発光させることである。制限内で、波型の深さま たは幅はモード間の接合の強さを制御する(深さが深い ほど高い接合を提供する)。典型的に、波型の深さは5 0 nm程度、即ち活性層の深さと同様でよい。しかし、 波型の周期がより重要である。

【0025】(周期) 導波路モードは活性材料と透明 I T O電極の両方にわたって設けられてもよく、導波路モードは I T O層内に独占的に設けられていてもよいことは認識されている。しかし、 I T Oの屈折率が活性層の屈折率よりも十分小さいならば、実際には I T O層内に独占的にある導波路モードは無視することができる。

【0026】多くの層を有する実際の素子構造は多くの 導波路モードを支持することができる。しかし、以下の 理由のために、2つの導波路モードしか考慮する必要は ない。1つは、発光層中に支持された導波路モードであ り、他方は基材から発光層までの全体に支持されたモー ドである。層および基材の典型的な屈折率は次の通りで ある: 発光層は1.8~1.9; 導電性ポリマー層 (ま たは正孔輸送層) は1.5~1.6; ITO層は1.8 ~2.0;基材(または光重合層)は1.55。発光層 は一般に、発光のスペクトル近くに吸収端があるため に、高い屈折率を有する。導電性ポリマー層または正孔 輸送層は発光層より低い屈折率を有する。導電性ポリマ ーは狭い禁止帯幅のポリマーであり、可視領域でむしろ 低い屈折率を有する。正孔輸送層は発光スペクトルに対 して透過性であるべきであり、より低い屈折率になる。 導電性ポリマー層(または正孔輸送層)の屈折率は基材 屈折率と同程度である。導電性ポリマー層(または正孔

8

輸送層)は、発光層から発光された光を発光層内に閉じ込める被覆層として機能する。空気の屈折率が系の中で最も低い屈折率であるので、導電性ポリマー層(または正孔輸送層)を通過した光が全て放射モードに入るわけではない。いくらかの光は基材と空気間の界面で反射され、発光層から導電性層、基材までの構造内に閉じ込められる。

【0027】図7は、本発明による発光素子の改良された効率を達成するように、制御されるべき波型活性層の種々のパラメータを示す。この観点において、色々なパ 10ラメータに関して、以下のような式が誘導され得る。

2 n h k c o s θ m – 2 ϕ a – 2 ϕ b = 2 m π β = n k s i n θ m $k = 2 \pi / \lambda$ o

活性層の波型表面に沿った隣接部分を考えると、位相差が各隣接部分からの放射線の発光において存在することは明らかである。放射モード出力は従って、波型ピッチ 30の長さによって分離される部分からの出力が一相内にあるように確保することによって増強される。従って、活性層に沿った位相差、 $\Delta \phi$ が波型のピッチ、 Λ と、活性層内の伝播定数、 β の積に等しくなるように構成すべきである。例えば、図7において矢印AおよびBで示す2つの地点の放射線の発光は、互いに一相内にあるべきである、即ち $\Delta \phi = \beta \Lambda$ を確保するように構成される。従って強力な放射モードの発光のためには:

 $\Delta \phi = \beta \Lambda = 2 \pi v \quad (v = 1, 2, 3...)$ 故に: $\Lambda = v \lambda$ 。/n s i n θ m である。

【0029】即ち、波長え。の放射モードにおいて強力な発光を達成するのに必要なピッチは角 θ mの比較的単純な関数であり、この角は活性層の深さおよび屈折率および接合される導波路伝搬モード数によって決定される。

【0030】(周期構造)波型表面は、図8(a)の3 1000cm⁻¹であるので、活性層上に陰極を有するつの実施例の第1番目に示すように、単純な回折格子の 構造を本発明に使用することができるが、恐らく理想的形状を有することは図1~4から理解されるであろう。 ではない。電子輸送被覆層を好ましくは、活性層と陰極これは1つの事例かもしれないが、これに限らず他の周 50 の間に配置する。電子輸送被覆層は、高い電子移動度お

期パターンを用いてもよい。一次元の周期構造として考 えられる他の形状を図8(a)に他の2つの実施例とし て示す。更に、例えば、図8(b)に示すフォーマット を有する2または3次元の周期構造として考えられるも のを使用することができる。これらは本質的に光子の禁 止帯幅構造である。これらはある波長でのある方向の伝 搬を止める。図8(b)に示す2つの実施例のうち、オ フセットパターン(2番目の実施例)が、全てのドット 間距離がΛに等しいことを示しているので、最も効果的 であると考えられる。更に別の例は、図8(c)に示す 例の、いわゆるチャープ格子 (charping grating) を使 用することである。通常、格子の使用は狭いスペクトル を生じる。しかし、狭い格子の制限なく高効率が要求さ れる場合には、チャープ格子を用いることができる。こ れは幅広いスペクトルを生じる。効率は改良され、素子 からの発光は材料の本来の発光特性により依存する。

【0031】(光損失)放射モードに接合した導波路モードから強力な発光を得るために、導波路モードでの光損失を最小にすることが必要である。導波路における光は放射モードで直接発光された光に比べて非常に長い距離を移動する。たとえ少しの吸収でも活性層中に閉じ込められたフィールド強度を弱めることとなり、放射モードに接合した導波路モードからの発光を少なくすることになる。

【0032】波型表面を有さない平坦な導波路から来る光と、波型の導波路を通った光を考えると;光の幾分かは平面から外に屈折し、残りの部分は導波路内に反射する。電界強度は指数関数的である。平面領域での強度は入射光と反射光の合計である。波型領域での減衰曲線は $I=e^{-\gamma}$ *として記載することができ、ここで γ は導波路モードの放射モードとの接合係数を表す。導波路での吸収は、即ち $I=e^{-\alpha}$ *で記載することができ、ここで α は吸収係数である。導波路モードから強力な発光を有するために、好ましくは少なくとも10のファクターで、接合係数 γ は吸収係数よりも小さくあるべきである

【0033】活性材料、例えば、発光低分子および発光 共役ポリマーの基礎吸収は接合係数に比べて透過スペクトル領域において(例えば、1000cm⁻¹以下)十 40 分小さい。導波路モードでの吸収は活性層での吸収からだけでなく、隣接層による吸収からも発生する。隣接層からの吸収は、隣接層に存在する一過性の光のエネルギーを隣接層の媒体が吸収することができるために、発生する。陰極は金属で作られており、これは大きい吸収を有するので、陰極が活性層上に形成される場合には、導波路での吸収は金属によって規定される。吸収の程度は1000cm⁻¹であるので、活性層上に陰極を有する構造を本発明に使用することができるが、恐らく理想的ではない。電子輸送被覆層を好ましくは、活性層と陰極の間に配置する。電子輸送被環層は、高い電子移動度な

よび陰極の仕事関数に対するそのLUMOレベルの良好なマッチングを有する材料から作られるべきである。高い移動度に関して、低分子系は共役ポリマーよりこの目的により適しているかもしれない。

【0034】導波路での低吸収を達成するための好ましい構造を図10に示す。この構造は、その上に光重合層210を有する基材200を包含する。基材200と接する表面と反対側の光重合層210の表面は波型で透明電極220がその上に設けられる。次に導電性ポリマー層または正孔輸送層230が電極220上に設けられ、次いで発光層240が配置される。電子輸送層250が発光層上設けられ、構造の最上部は電極260である。層210の波型に電極260を含む全ての後続の層が従う。この構造では、電子輸送層の厚さは発光層と電子輸送層の界面での一過性の光の侵入深さより厚くあるべきである。

【0035】活性層での散乱も光損失を増加させる。散乱光はしかし、素子から発光され、従って散乱は効率を低下させない。しかし、散乱が大きい場合には、(波型パターンの周期により)素子に期待されるべき狭いスペ 20クトル出力を得ることが困難である。低分子系は一般に、粗い表面を有し、多くの散乱点を有する。非晶質共役ポリマーはその低散乱特性のために、活性層により好適である。

【0036】導波路モードでの光損失は活性層による吸収からだけでなく、隣接層による吸収からも生じる。隣接層による吸収は、活性層界面での反射が理想表面からの反射でなく、実際には界面深さを横断する反射であるために、生じる。更に、ドメインオーダリングが活性層中に生じ、これは多結晶構造に類似している。即ち、散 30 乱が生じこれも導波路モードでの光損失を起こす。

【0037】活性材料の吸収係数 α は、導波路モードでの光損失を低減するのに重要である。典型的に、低分子系は500 $cm^{-1}\sim$ 1000 cm^{-1} の範囲に吸収係数を有する。

【0038】低分子系を用いた組み立て方法は層中に欠陥を生じ、高度の散乱を生じる。これに比べて、ポリマー材料はインクジェット技術を用いて塗布でき、従って、低欠陥、低散乱の活性層を塗布することができる。 【0039】材料中での光損失の強度は、以下のように、材料における吸収係数α、距離xに依存する。

従って、吸収係数が大きいと、材料の深さ(例えば、1 0μ m以内)で吸収に激しい変化を生じる。 $1 0 \mu$ mの 層厚は大きい接合を生じず、従って $1 0 \mu$ mは下側限界 と考えることができる。1 0 0 c m $^{-1}$ の吸収係数は1 $0 0 \mu$ mの吸収深さに対応することになり、これは所望 の接合を形成するのに十分良好である。故に、共役ポリマーのような材料の使用は、活性層として低分子系の使用より望ましい。また、もちろん多くの異なったポリマ 50

一材料があり、多結晶タイプの相を示すものもあれば、 非晶質相を示すものもある。本発明による素子の活性層 用には非晶質共役ポリマーを使用するのが好ましい。ポ リフルオレン誘導体が特に、本発明による素子において 強力な発光を有する好適な材料である。

【0040】本発明の実施態様を好ましくは、1000 cm⁻¹以下、より好ましくは500cm⁻¹以下の吸収係数を有する発光材料を用いる。

[0041]

【実施例】 (第1の実施例) 第1の実施例は本質的に図1 の方法に従って調製した。かかる実施例はガラス基材お よびエポキシ光重合樹脂を使用した。フォトリソグラフ ィーによってパターン化された電着ニッケルスタンパー を用いて波型表面を形成した。300、330、36 0、および450nmのピッチサイズを有する一次元周 期構造を有するスタンパーを用い波型の深さを50nm にセットした。ガラス基材をシリルカップラーで処理し て、樹脂層との十分な接着性を確保した。ITO層を、 ArおよびO₂スパッタリングガスを用いた200℃で のスパッタリングによって、樹脂層上に塗布した。IT O層の厚さは120nmであった。F8BT、ポリ (9, 9-ジオクチルフルオレン-コー2, 1, 3-ベ ンゾチアジアゾール) で形成された活性層をスピン塗布 によってITO層上に塗布した。F8BTは低い光損失 を有する非晶質材料である。活性層は140nmの厚さ および100 c m - 1以下の吸収係数を有した。 C a 1 00nm/Al300nmで形成された金属電極を蒸着 **塗装によって活性層上に設けた。**

【0042】第1の実施例の発光素子は高い指向性と高効率の狭い線幅の出力を有した。典型的に、線幅は20nm以下であり最良の結果は330nmおよび360nmの波型のピッチで得られた。これらのピッチは所望の波長(これはF8BTの蛍光スペクトルの範囲内である)で強力な発光を得るという要求を満足する。

【0043】この実施例で達成されたスペクトル出力を図9に示す。

【0044】(第2の実施例)第2の実施例を本質的に図2の方法に従って形成した。かかる実施例は平坦なITO層を備えたガラス基材を使用した。導電性ポリマー40層を、PEDOT(ポリー3,4-エチレンジオキシチオフェン)およびPSS(ポリースチレンースルホン酸)の1:5~1:100の割合の混合物の水溶液を用いて形成した。PSSは本質的にPEDOT材料用の可撓性マトリックスとして使用した。PPSは従来のポリマーであって、これはスタンピングおよび鋳造処理を行うのが比較的容易である。PEDOTは共役ポリマーであって、これは非共役ポリマーほど容易に処理されない。これはより高い導電性を有するが、より低可塑性のバルク特性を有する。薄層の使用は、導電性の重要性を50低減するので希釈されたPEDOTの使用は許容でき

る。PEDOTは小さい吸収性を有し(吸収係数が可視 領域で約0.04である)、そこで可視領域で透過性で あるPSSでの希釈によって吸収性を低減することがで きる。このPEDOTは導波路のコアを形成しないが、 コアに閉じ込められた光分布末端がこのPEDOT層に 存在しうる。導波路の損失は低吸収性を有するこの希釈 PEDOTを適用することによって低減することができ る。

【0045】(ニッケルスタンパーを用いて形成された)ポリマースタンパー型を用いて導電性ポリマー層の 10 表面を波型形成した。即ち、ポリマー溶液をITO層上に塗布しポリマースタンパー鋳型を溶液に適用し、80℃で24時間放置して乾燥させた。鋳型を次に除去し活性層をスピン塗布によって塗布した。活性層はF8BT、ポリ(9,9ージオクチルフルオレンーコー2,1,3ーベンゾチアジアゾール)で140nmの厚さに形成した。吸収係数は100cm⁻¹以下であった。Ca100nm/Al300nmで形成された金属電極を蒸着塗装によって活性層上に提供した。

【0046】第2の実施例の発光素子を第1の実施例の 20 発光素子と非常に類似した出力特性を示した。

【0047】第2の実施例の第1の改良された実施例は、本質的に図3の方法を用いて形成した。即ち、導電性ポリマー溶液をニッケルスタンパーおよびITO層上にスピン塗布した。このように形成された2つの構成要素を一体に真空中で200℃で5分間プレスし、次いでニッケルスタンパーを引き離した。先の実施例と同様の結果が得られた。

【0048】第2の実施例の第2の改良された実施例を、本質的に図4の方法を用いて形成した。即ち、導電 30性ポリマー溶液を可塑性の鋳型およびITO層上にスピン塗布した。2つの構成要素を一体に結合させ、真空中で80℃で24時間乾燥した。次いで可塑性の鋳型を除去した。再度先の実施例と同様の結果が得られた。

【0049】(第3の実施例)第3の実施例を本質的に第1の実施例で使用した方法および材料に従って形成したが、この場合にはスタンパーをドットの配列に浮き彫りにした。即ち、周期構造は図8(b)に示すタイプであった。第3組の実施例は高指向性の出力を示し、発光ピークは第1の実施例のものに対して2.5倍であった。第1の実施例の一次元周期構造は「線」の出力指向性を生じるが、第3の実施例の二次元周期構造は「柱状」の出力指向性を生じる。

【0050】 (第4の実施例) 第4の実施例を本質的に 第1組の実施例で使用した方法および材料に従って形成 したが、この場合にはスタンパーを「チャーピング」格 子に浮き彫りにした。即ち、周期構造は図8(c)に示す タイプであった。第4の実施例は高効率および幅広いスペクトル出力を示した。

【0051】(第5の実施例)第5の実施例は本質的に第1組の実施例で使用した方法および材料に従っているが、この場合にはスタンパーは異なる周期または異なる設計の格子を同じ基材上に備えていた。従って、格子のそれぞれ1つを有する各領域は各波長をそれぞれ強め、従って実施例は複数色の出力を提供した。出力の高指向性は液晶表示パネルで従来から実用化されているもののような表示素子用としての素子の有用性を低減する。しかし、出力の高指向性は投影表示装置のようないろいろな別の用途に特に好適な素子を提供する。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態による発光素子に使用するための基材を形成する方法をその工程に沿って示す断面 図。

【図2】本発明の実施形態による発光素子に使用するための基材を形成する別の方法をその工程に沿って示す断面図。

(図3)本発明の実施形態による発光素子に使用するための基材を形成する更なる方法をその工程に沿って示す断面図。

【図4】本発明の実施形態による発光素子に使用するための基材を形成するまた別の方法をその工程に沿って示す断面図。

【図5】図1に示す方法により製造された基材を用いた 発光素子を示す断面図。

【図6】図2、3または4のいずれかに示す方法により 製造された基材を用いた発光素子を示す断面図。

【図7】活性層のためのピッチ選択に関する色々なパラメータを示す図。

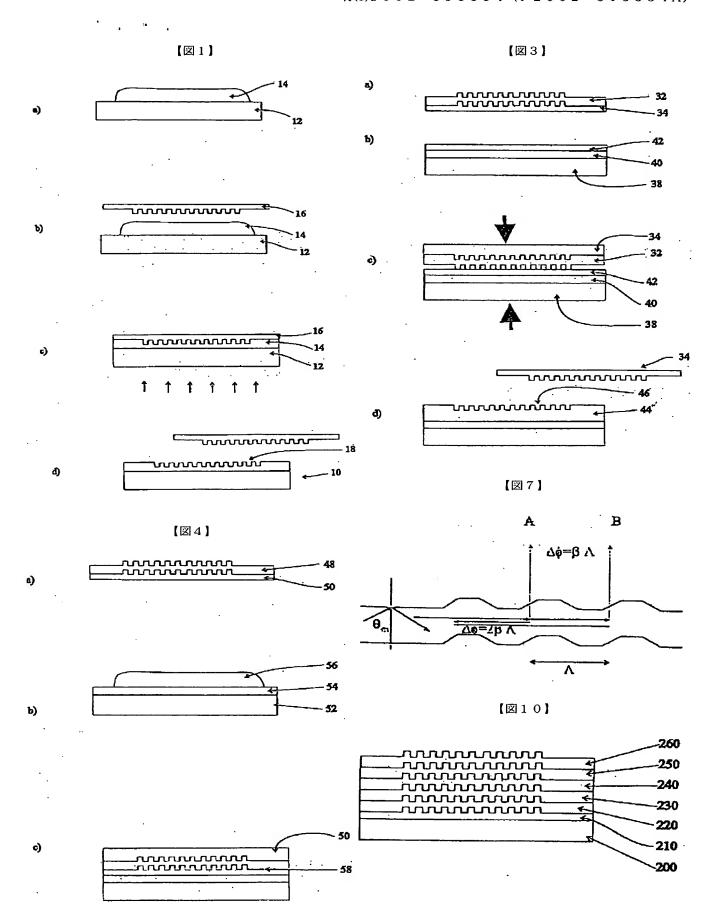
【図8】本発明を実施する際に採用することができる種々の周期構造を示す図。

【図9】本発明による実施態様の一例のスペクトル出力を示す図。

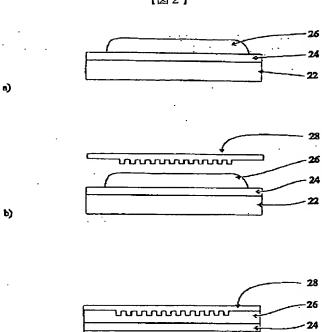
【図10】導波路における低吸収を達成するための好ましい構造を示す断面図。

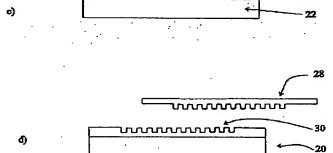
【符号の説明】

- 10 基材
-) 12 透明基材
 - 14 樹脂
 - 16 スタンピング型
 - 18 波型の上側表面
 - 100 透明基材
 - 120 透明電極
 - 140 発光材料層 (発光ポリマー)
 - 160 金属電極

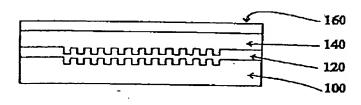




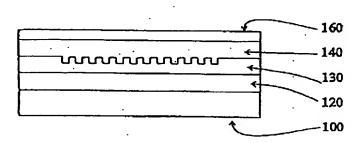




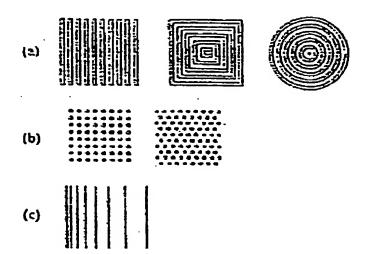
【図5】



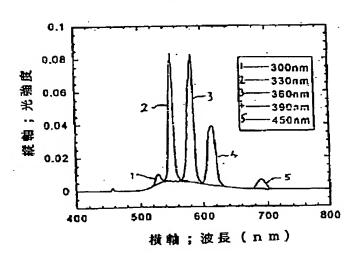
【図6】







【図9】



フロントページの続き

(71)出願人 501023524

ケンブリッジ大学テクニカルサービスリミ テッド

Cambridge Universit y Technical Service s Limited ザ オールド スクールズ トリニティ

サ オールド スクールズ トリニティ レーン ケンブリッジ CB2 1TS イギリス

The Old Schools Trinity Lane Cambridge CB2 1TS United Kingdom

(72)発明者 川瀬 健夫

イギリス ケンブリッジ CB2 1TS トリニティ レーン ザ オールド ス クールズ ケンブリッジ大学テクニカルサ ービスリミテッド内

Fターム(参考) 3K007 AB03 AB04 AB18 BA00 CB01 CB04 DA01 DB03 EB00 FA01